ДИНАМИКА РЕШЕТКИ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

УДК 548.0

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ КРИСТАЛЛОВ СЕМЕЙСТВА ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ

© 2012 г. Д. Г. Санников

Институт кристаллографии РАН, Москва E-mail: sannikov@ns.crys.ras.ru Поступила в редакцию 15.02.2012 г.

Изложен метод построения теоретических фазовых диаграмм для кристаллов семейства тетраметиламмония. Построены фазовые диаграммы температура—давление для различных кристаллов из этого семейства. Проведено их сравнение с экспериментальными диаграммами. Обсуждаются используемые предположения и приближения.

МЯГКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ СПЕКТРА НОРМАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ КРИСТАЛЛА

Во многих кристаллах при изменении температуры T, давления P, электрического поля E наблюдается сложная последовательность фазовых переходов с участием несоразмерной фазы. В целях большей наглядности используем терминологию теории динамики кристаллической решетки. Естественно предполагать, что мягкая оптическая ветвь нормальных колебаний кристалла ответственна за всю совокупность наблюдаемых фазовых переходов (**ФП**).

Три простейшие зависимости коэффициента упругости мягкой оптической ветви $\alpha(q)$ от безразмерного волнового числа q ($\mathbf{q} = qa^*, b^*, c^*$) охватывают широкий круг кристаллов, изученных экспериментально.

$$\alpha(q) = \alpha - \sigma q + \delta q^2, \quad \sigma > 0, \quad \delta > 0.$$
(1)

Наличие линейного по q члена в (1) означает, что соответствующий термодинамический потенциал содержит инвариант Лифшица [1]. Примерами кристаллов соответствующего типа являются селенат калия K₂SeO₄ и фторберилат аммония (NH₄)₂BeF₄. Эти кристаллы не будут здесь рассматриваться. В них наблюдается последовательность двух ФП как при изменении *T*, так и при изменении *P*: $C - IC - C_{m/l}$, где C – исходная, IC – несоразмерная, $C_{m/l}$ – соразмерная фазы (m/l = 1/3 или 1/2).

 $\alpha(q) = \alpha - \delta q^2 + \kappa q^4$, $\delta > 0$, $\kappa > 0$. (2) Примерами кристаллов являются тиомочевина SC(NH₂)₂, **BCCD** (бетаин кальций хлорид дигидрат). В этих кристаллах наблюдались фазовые диаграммы T-P, T-E, и T-P при $E \neq 0$. Предлагаемый метод был применен к этим кристаллам и были построены соответствующие фазовые диаграммы ([2, 3], [4] и цитируемая там литература). Здесь эти кристаллы рассматриваться также не будут. $\alpha(q) = \alpha - \delta q^2 - \kappa q^4 + \tau q^6, \quad \kappa > 0, \quad \tau > 0.$ (3)

Это случай большого семейства хорошо изученных кристаллов тетраметиламмония (**TMA**): TMA–MX, где TMA – [N(CH₃)₄]₂, M – металл (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), X – галоген (Cl, Br, I) [5, 6]. Для трех кристаллов (далее) будут построены фазовые диаграммы температура T – давление P. Метод построения теоретических T–P-диаграмм основан на феноменологическом подходе к проблеме дьявольской лестницы [7].

Оптическая ветвь (3) для ТМА-кристаллов имеет в определенном диапазоне значений коэффициента δ (— $\kappa^2/3\tau < \delta < 0$) два минимума. Один — в произвольной точке зоны Бриллюэна — определяющий, как и в случаях (1) и (2), ФП из исходной *C* в несоразмерную *IC*-фазу. Другой — в точке q = 0 — определяющий ФП из исходной *C* в соразмерную C_0 -фазу с q = 0, т.е. имеющую ту же элементарную ячейку.

На рис. 1 представлена зависимость $\alpha(q)$ (3) при различных значениях коэффициента δ. При значении $\delta = -\kappa^2/3\tau$ исчезает минимум в произвольной точке зоны Бриллюэна (на рис. 1а горизонтальной линией отмечена точка перегиба при q = b). В интервале значений $-\kappa^2/3\tau < \delta < -\kappa^2/4\tau$ осуществляется переход из C в C₀-фазу. При значениях $-\kappa^2/4\tau < \delta \le 0$, а также при $\delta > 0$ вплоть до значения, отвечающего $q = q_{Br}$, осуществляется переход из *C* в *IC*-фазу. При значении $\delta = -\kappa^2/4\tau$ оба минимума одновременно обращаются в ноль. На фазовой диаграмме возникает тройная точка, в которой сходятся три линии $\Phi \Pi C - IC$, $C - C_0$, C_0 -*IC*. Назовем ее *LT*-точкой (*Lifshitz type*). По своим свойствам она отличается от *L*-точки (Lifshitz). Заметим, что L-точка могла бы наблюдаться на фазовых диаграммах для случая (2), однако экспериментально она не была обнаружена ни в тиомочевине (отрицательные давления), ни в *BCCD* (высокие давления порядка 10⁶ кПа).



Рис. 1. Зависимость коэффициента упругости $\alpha(q)$ мягкой оптической ветви от безразмерного волнового числа q при различных значениях коэффициента δ : $\delta = -\kappa^2/3\tau$ (a), $-\kappa^2/3\tau < \delta < -\kappa^2/4\tau$ (b), $\delta = -\kappa^2/4\tau$ (c), $-\kappa^2/4\tau < \delta < 0$ (г), $\delta = 0$ (д).

Зависимость (3) целесообразно переписать в виде:

$$\begin{aligned} \alpha(q) &= a + \Delta(q), \\ \Delta(q) &= \tau(b^2 + q^2)^2 [2(b^2 - q_L^2) + q^2], \\ \alpha(b) &= a, \quad \alpha(q_{m/l}) = a + \Delta_{m/l}, \\ \Delta_{m/l} &\equiv \Delta(q_{m/l}), \quad \alpha = a + \Delta_0, \end{aligned}$$
(4)

 $\Delta_0 \equiv \Delta(0), \quad \delta = \tau b^2 (3b^2 - 4q_L^2), \quad q_L^2 = \kappa/2\tau.$ Здесь введены две новые переменные *a* и *b* и вели-

чина q_L^2 , имеющие определенный физический смысл: *а* и *b* – координаты минимума оптической ветви в произвольной точке зоны Бриллюэна, величина q_L^2 – разная для разных кристаллов и, можно сказать, их определяет. Кроме того, в (4) введены удобные обозначения $\Delta_{m/l}$, Δ_0 , а коэффициент δ выражен через b^2 и q_L^2 .

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

Мягкая оптическая ветвь, определяемая (3) или (4), является двукратно вырожденной, поскольку $\alpha(q) = \alpha(-q)$, следовательно, параметр порядка – двукомпонентный. Компоненты η и ξ можно рассматривать как амплитуды двух мод с qи -q, которые принадлежат этой ветви. Используя более удобную полярную систему координат: $\eta = \rho \cos \varphi$ и $\xi = \rho \sin \varphi$, запишем термодинамический потенциал в виде

$$\Phi = \alpha(q)\rho^2 + \beta\rho^4 + \gamma\rho^6 - \alpha'_l \rho^{2l} \cos 2l\varphi, \qquad (5)$$

где $\alpha(q)$ берется из (3) или (4) (не следует путать зависимость $\alpha(q)$ и коэффициент α). Коэффициент α_l' при анизотропном (в пространстве η , ξ) инварианте отличен от нуля только для рациональных значений $q = q_{m/l} = m/l$, где *m* и *l* – целые числа.

Для ІС-фазы потенциал принимает вид

$$\Phi_{IC} = \alpha(b)\rho^2 + \beta\rho^4 + \gamma\rho^6, \quad \alpha(b) = a.$$
(6)

Минимизируя потенциал (5) по φ , получим два решения: sin/ $\varphi = 0$, устойчивое при $\alpha'_l > 0$, и

 $\cos l\varphi = 0$, устойчивое при $\alpha'_l < 0$. Потенциал соразмерной фазы $C_{m/l}$ для обоих решений приобретает вид:

$$\Phi_{m/l} = \alpha(q_{m/l})\rho^2 + \beta\rho^4 + \gamma\rho^6 - |\alpha'_l|\rho^{2l}.$$
 (7)

Для C_0 -фазы с q = 0, эквитрансляционной с Cфазой, потенциал имеет вид

$$\Phi_0 = \alpha \zeta^2 + (2/3)\beta \zeta^4 + (2/5)\gamma \zeta^6.$$
(8)

Параметр порядка ζ в этом случае однокомпонентный. Численные множители при коэффициентах β и γ связаны именно с этим обстоятельством. Подробный вывод выражения (8), исходя из требования его согласованности с (6) и (7), можно найти, например, в [4]. Потенциал исходной *С*-фазы $\Phi_C = 0$.

Для фазы $C_{1/2}$ (l = 2) в потенциале (5) следует дополнительно учитывать анизотропный инвариант $\alpha_2^{"}\rho^6\cos 4\varphi$, который в потенциале (7) принимает вид $-|\alpha_2^{"}|\rho^6$. Однако этим инвариантом можно пренебречь, поскольку в $\Phi_{1/2}$ уже есть анизотропный инвариант $\alpha_2^{'}\rho^4\cos 4\varphi$ более низкой степени по р. Для фазы $C_{1/3}$ (l = 3) в потенциале $\Phi_{1/3}$ следует учитывать инвариант $\gamma\rho^6$ и потребо-

вать выполнения неравенства $\gamma - |\alpha'_3| \ge 0$. Очевидно, что инвариант $\gamma \rho^6$ нужно учитывать во всех потенциалах (что и было сделано).

В дальнейшем оказывается удобным использовать переменные ϕ , *R* и параметры *A*, *B*, *Q*_{*L*}, *Q*_{*l*}, *D*_{*l*}, *D*₀, *D*, *A*_{*l*}, *A*_{γ}:

$$\Phi = \phi \Phi_0, \quad \rho = RR_0, \quad \zeta = RR_0,$$

$$\Phi_0 = (\tau Q^6)^2 / \beta, \quad R_0^2 = \tau Q^6 / \beta, \quad a = -A\tau Q^6,$$

$$b = BQ, \quad q_L = Q_L Q, \quad q_{m/l} = Q_l Q,$$

$$\Delta_{m/l} = D_l \tau Q^6, \quad \Delta_0 = D_0 \tau Q^6, \quad \delta = D\tau Q^4,$$

$$|\alpha'_l| = (2\beta A_l)^{l-1} / (\tau Q^6)^{l-2}, \quad |\alpha'_2| = 2\beta A_2,$$

$$|\alpha'_3| = (2\beta A_3)^2 / \tau Q^6, \quad \gamma = (2\beta A_\gamma)^2 / \tau Q^6.$$

$$(9)$$

Здесь Q – число, вводимое для меньшего разброса в задаваемых численных значениях параметров Q_L , A_l , A_γ (для всех рассматриваемых кристаллов



Рис. 2. Фазовая *D*–*А*-диаграмма для кристалла TMA– MnCl₄.

выбрано Q = 0.5). Для удобства знак A берется противоположным знаку a.

Термодинамические потенциалы (6)–(8) в обозначениях (9) принимают вид:

$$\phi_{IC} = -AR^2 + R^4 + 4A_{\gamma}^2 R^6,$$

$$\phi_{m/l} = -(A - D_l)R^2 + R^4 + 4A_{\gamma}^2 R^6 - (2A_l)^{l-1} R^{2l}, (10)$$

$$\phi_0 = -(A - D_0)R^2 + (2/3)R^4 + (8/5)A_{\gamma}^2 R^6.$$

Варьируя потенциалы (10) по переменной *R*, получим:

$$\begin{split} \phi_{IC} &= -(1/6^{3}A_{\gamma}^{4})\{[1+12A_{\gamma}^{2}A]^{3/2} - [1+18A_{\gamma}^{2}A]\},\\ \phi_{0} &= -(1/0.54\times 6^{3}A_{\gamma}^{4})\{[1+0.9\times 12A_{\gamma}^{2}(A-D_{0})]\},\\ \phi_{1/2} &= -(1/6^{3}A_{\gamma}^{4})\{[(1-2A_{2})^{2}+12A_{\gamma}^{2}(A-D_{2})]\},\\ (2A_{2})^{2}+18A_{\gamma}^{2}(A-D_{2})]\},\\ (2A_{2}\geq 1),\\ \phi_{1/3} &= -[1/6^{3}(A_{\gamma}^{2}-A_{3}^{2})^{2}]\times\\ \times\{[1+12(A_{\gamma}^{2}-A_{3}^{2})(A-D_{3})]^{3/2} - \\ -[1+18(A_{\gamma}^{2}-A_{3}^{2})(A-D_{3})]\},\\ (A_{\gamma}^{2}-A_{3}^{2}\geq 0),\\ \phi_{m/l} &= -(1/6^{3}A_{\gamma}^{4})\{[1+12A_{\gamma}^{2}(A-D_{l})]^{3/2} - \\ -[1+18A_{\gamma}^{2}(A-D_{l})]\} - \\ -(1/2A_{l})\{(A_{l}/6A_{\gamma}^{2})[1+12A_{\gamma}^{2}(A-D_{l})]^{1/2} - 1\}^{l},\\ (l>3) \end{split}$$

В выражении для $\Phi_{m/l}$ (l > 3) второе слагаемое предполагается малым по сравнению с первым (условие слабой анизотропии), по нему проводится разложение.

ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ФАЗАМИ

Приравнивая потенциалы (11) друг к другу, получим выражения для границ между фазами. Поскольку потенциал *C*-фазы $\Phi_C = 0$, то для границ *C*-*IC* и *C*-*C*₀ получаются простые выражения соответственно

$$A = 0, \quad A = D_0.$$
 (12)

Выражения для других границ приводить не имеет смысла: это сведется лишь к многократному переписыванию потенциалов (11), приравненных друг к другу (сократится лишь общий множитель 6³, а также A_{γ}^4 – кроме границ с фазой $C_{1/3}$). В дальнейшем будем ссылаться на потенциалы (11) как на выражения для границ между фазами.

Заметим, что три границы C-IC, $C-C_0$ и $IC-C_0$ сходятся в одной точке, названной LT-точкой. Также пересекаются в одной точке (как и должно быть) три другие границы $IC-C_{1/3}$, $IC-C_0$ и $C_{1/3}-C_0$. LT-точке отвечают значения

$$A = 0, \quad B = Q_L, \quad D_0 = 0, \quad D = -Q_L^4.$$
 (13)

Приведем еще выраженные через B^2 величины D, D_0, D_l, D_2, D_3 , которые входят в потенциалы (11). Согласно (4) и (9):

$$D = B^{2}(3B^{2} - 4Q_{L}^{2}), D_{0} = 2B^{4}(B^{2} - Q_{L}^{2}),$$

$$D_{l} = (B^{2} - Q_{l}^{2})^{2}[2(B^{2} - Q_{L}^{2}) + Q_{l}^{2}],$$

$$D_{2} = (B^{2} - 1)^{2}[2(B^{2} - Q_{L}^{2}) + 1],$$

$$D_{3} = (B^{2} - 4/9)^{2}[2(B^{2} - Q_{L}^{2}) + 4/9].$$
(14)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ

Выражения (11), (12) для границ между фазами позволяют строить теоретические фазовые диаграммы. Для этого, прежде всего, нужно выбрать на плоскости оси координат. В качестве оси абсцисс оказывается удобным выбрать величину D, а оси ординат — величину A, (9). При значении A = 0осуществляется ФП второго рода из С в ІС-фазу. Общий характер *D*-А-диаграммы можно видеть на рис. 2. Численное значение величины А₁ для каждой С_{*m*/*l*}-фазы определяет ее относительную ширину на диаграмме. Численное значение величины Q_L определяет положение LT-точки относительно других реперных точек на оси *D*. Для построения *D*-А-диаграммы для каждого конкретного кристалла задаем последовательно значения B^2 . Из (14) определяем значения D, D_0, D_l , которые входят в (11). Из (11) методом последовательных приближений находим соответствующие значения А. Строим по точкам фазовую D-А-диаграмму.

Подчеркнем, что эта диаграмма является результатом рассматриваемой методики. На ней есть все фазы, наблюдаемые в эксперименте. Но главное – есть тройная *LT*-точка, появление ко-

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 57 № 6 2012

торой обусловлено зависимостью коэффициента упругости мягкой оптической ветви по типу (3), более сложному, чем (1) и (2). При значениях q, меньших q_{LT} , на фазовых диаграммах *IC*-фаза от-сутствует.

Для того чтобы провести сравнение с экспериментом, надо из D-A- диаграммы получить T-Pдиаграмму. Очевидно, что координаты минимума мягкой оптической ветви (в произвольной точке зоны Бриллюэна) a и b, (4), или A и B, (9), а следовательно, и D, (14), зависят от T и P. Предполагаем простейшую линейную зависимость D и A от Tи P. Тогда оси T и P на D-A-диаграмме – прямые линии. Их ориентация выбирается так, чтобы оси T и P пересекали те же фазы, что и на экспериментальной T-P-диаграмме. Теперь, исходя из D-A-диаграммы, строим теоретическую T-Pдиаграмму.

Заметим, что D—A-диаграмма ограничена слева значением $D = -(4/3)Q_L^4$. При меньших значениях D величина B, как следует из (14), становится комплексной. Выше это отмечалось для значения δ и величины b ((4) и рис. 1). Теоретический подход, основанный на использовании соотношения (4), становится неприменимым при $D < < -(4/3)Q_L^4$.

Ниже будут последовательно построены теоретические T-P-диаграммы для трех кристаллов из TMA-семейства (MnCl, CuBr, ZnI), фазовые диаграммы для которых имеют принципиальные различия. Затем проведено их сравнение с экспериментальными диаграммами.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ КРИСТАЛЛА ТМА-MnCl₄

Экспериментальные фазовые T-P-диаграммы для кристалла ТМА-МпСl₄ [8] (также диаграммы в [9–11]) представлены на рис. За. Пр. гр. исходной *C*-фазы – D_{2h}^{16} или *Ртсп* (в установке *bca*, обычной для ТМА-кристаллов). Вектор модуляции *IC*-фазы $\mathbf{q}_z = qc^*$. Пр. гр. соразмерных фаз следующие: C_0 -фазы $C_{2h}^5(P12_1/c1)$, $C_{1/3}$ -фазы $C_{2h}^5(P112_1/n)$, $C_{2/5}$ -фазы $C_{2\nu}^9(P2_1cn)$, $C_{3/7}$ -фазы $D_2^4(P2_12_12_1)$ и $C_{1/2}$ -фазы $C_{2h}^5(P2_1/c11)$ (обзоры [5, 6] и цитируемая в них литература). Перечисленные группы симметрии находятся в согласии с утверждением, что все фазы продуцируются одной мягкой оптической ветвью спектра нормальных колебаний кристалла.

Для построения теоретической фазовой *D*–*A*диаграммы были выбраны следующие значения параметров:

$$Q_L^2 = 0.55, \quad 2A_2 = 0.75, \quad A_\gamma = A_3 = 1,$$
 (15)
 $A_5 = 0.5, \quad A_7 = 1.$

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 57 № 6 2012



Рис. 3. Экспериментальная (а) и теоретическая (б) фазовая *T*–*P*-диаграмма для кристалла TMA–MnCl₄.

Они взяты с точностью до одной—двух значащих цифр. Принято упрощающее расчеты предположение $A_{\gamma} = A_3$. Построенная с использованием (11)—(14) *D*—*A*-диаграмма [12] представлена на рис. 2. Прямые линии проведены при тех *D*, которые отвечают значениям, указанным на линиях рис. 3а.

На D—A-диаграмме рис. 2 ориентация осей T и P определяется значениями сtg TD = 0.3, сtg PA = 0.5 (тоже с точностью до одного знака). Построенная на основе такого выбора теоретическая T—P-диаграмма [12] представлена на рис. 36. Сравнивая теоретическую и экспериментальную

3*



Рис. 4. Экспериментальная (а) и теоретическая (б) фазовая *T*–*P*-диаграмма для кристалла TMA–CuBr₄.

диаграммы (рис. 3а, 3б), можно видеть их неплохое соответствие друг другу, особенно, если принять во внимание приближения и предположения, сделанные при конструировании теоретических диаграмм (далее).

Подчеркнем, что экспериментальная фазовая Т-Р-диаграмма содержит большую информацию о кристалле. Сравнивая теоретическую Т-Р-диаграмму с экспериментальной, можно оценивать коэффициенты термодинамического потенциала для данного кристалла. Результаты, основанные на таком сравнении, представлены для кристалла ВССД в [3, 4]. Заметим, что для этого кристалла $C_{m/l}$ -фаза с m/l = 4/15 была обнаружена в эксперименте только после того, как она была приведена на теоретической фазовой Т-Е-диаграмме с указанием ее пространственной группы (фаза полярная и с ростом Е ее фазовое пространство увеличивается). Оба эти примера говорят о плодотворности рассматриваемого теоретического подхода к кристаллам со множественными ФП, включающими несоразмерную фазу.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ КРИСТАЛЛА ТМА-СиВr₄

Экспериментальная фазовая T-P-диаграмма для кристалла TMA-CuBr₄ [13] (также диаграммы для дейтерированного соединения [14]) представлена на рис. 4а. Пр. гр. исходной *C*-фазы D_{2h}^{16} или *Ртсп* (в установке *bca*, обычной для TMAкристаллов). Вектор модуляции *IC*-фазы $\mathbf{q}_y = qb^*$. Пр. гр. соразмерных фаз C_0 и $C_{1/2}$ соответственно C_{2h}^5 (*P*12₁/*c*1) и C_{2v}^5 (*Pbc*2₁) [15]. Отличительной особенностью фазовой диаграммы на рис. 4а является отсутствие $C_{1/3}$ -фазы. Это позволяет пренебречь инвариантом $\gamma\rho^6$ в термодинамических потенциалах ((5)–(8) и последующий текст). В



Рис. 5. Фазовая *D*–*A*-диаграмма для кристалла ТМА– CuBr₄.

результате существенно упрощаются выражения (11) для потенциалов. Полагая $\gamma = 0$ из (11) получим значения потенциалов для всех фаз, встречающихся на рис. 4а:

$$\Phi_{C} = 0, \quad \Phi_{IC} = -\frac{1}{4}A^{2}, \quad \Phi_{0} = -\frac{3}{8}(A - D_{0})^{2},$$

$$\Phi_{1/2} = -\frac{1}{4}\frac{(A - D_{2})^{2}}{1 - 2A_{2}}.$$
(16)

Приравнивая потенциалы (16) друг к другу, получим выражения для границ между фазами. Для границ *C*–*IC* и *C*–*C*₀ они приведены в (12). Для границ *IC*–*C*₀, *IC*–*C*_{1/2} и *C*₀–*C*_{1/2} соответственно получим:

$$A = c_0 D_0, \quad A = c_2 D_2,$$

$$A = (c_2 - c_0)^{-1} [c_0 (c_2 - 1) D_0 - c_2 (c_0 - 1) D_2], \quad (17)$$

$$c_0 = 3 + 6^{1/2}, \quad c_2 = (2A_2)^{-1} [1 + (1 - 2A_2)]^{1/2}.$$

Выбрав значения параметров $Q_L^2 = 0.8$ и $A_2 = 0.2$, строим фазовую *D*–А-диаграмму [16]. Она представлена на рис. 5. Ориентация осей *T* и *P*, показанных на *D*–*A*-диаграмме, определяется значениями ctg *TD* = ctg *PA* = 0.6. Заметим, что все значения берутся с точностью до одного знака.

На рис. 46 представлена полученная на основе рис. 5 теоретическая *Т*–*Р*-диаграмма [16]. Сравнивая рис. 4а и 46, можно видеть их удовлетворительное согласие.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ КРИСТАЛЛА ТМА–ZnI₄

Экспериментальная фазовая T-P-диаграмма для кристалла TMA-ZnI₄ [17] представлена на рис. 6а. Пр. гр. фаз C_1 , C_0 и $C_{1/2}$ такие же, как для кристалла TMA-CuBr₄.

Отличительной особенностью диаграммы на рис. 6а является отсутствие несоразмерной *IC*-

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 57 № 6 2012



Рис. 6. Экспериментальная (а) и теоретическая (б) фазовая *T*–*P*-диаграмма для кристалла TMA–ZnI₄.

фазы, которая наблюдается на экспериментальных T-P-диаграммах для всех кристаллов из семейства ТМА. Кроме того, на диаграмме рис. ба присутствует тройная точка между фазами C_1 , C_0 , $C_{1/2}$, наблюдаемая, по-видимому, впервые.

Обе эти особенности фазовой диаграммы можно объяснить при условии, что $\Phi \Pi C - C_{1/2}$ является переходом первого рода. Из экспериментально измеренной зависимости диэлектрической постоянной от температуры следует, что $\Phi \Pi C - C_{1/2}$ и $C_0 - C_{1/2}$ – первого рода, а переход $C - C_0$ – второго рода [17].

Используя (11), выпишем явные выражения для границ между фазами C_1 , C_0 , $C_{1/2}$. Для границы $C-C_0$ имеем: $A = D_0$ (12). Для границы $C_0-C_{1/2}$ получим:

$$[1+10.8A_{\gamma}^{2}(A-D_{0})]^{3/2} - [1+16.2A_{\gamma}^{2}(A-D_{0})] =$$

= 0.54{[(1-2A_{2})^{2} + 12A_{\gamma}^{2}(A-D_{2})]^{3/2} - (18)

$$-(1-2A_2)[(1-2A_2)^2+18A_{\gamma}^2(A-D_2)]\}.$$

Для границы $C - C_{1/2}$ получим:

$$A = D_2 - (1 - 2A_2)^2 / 16A_{\gamma}^2.$$
(19)

При построении D—A-диаграммы используем следующие значения параметров: $Q_L^2 = 0.9, A_2 = 0.7, A_{\gamma} = 0.4$. Построенная с использованием выражений (12), (18), (19) для границ между фазами теоретическая D—A-диаграмма [18] представлена на рис. 7. Штриховой линией A = 0 показана граница между фазами C и IC, которая существовала бы при условии, что все ФП были второго рода. Пересечение фазовых границ C— C_0 и C— $C_{1/2}$ препятствует появлению IC-фазы на диаграмме. Такое пересечение — следствие того, что ФП C— $C_{1/2}$ является переходом первого рода. Продолжение двух линий ФП C— C_0 и C— $C_{1/2}$ до их пересечения с линией A = 0 показано точечными линиями.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 57 № 6 2012



Рис. 7. Фазовая *D*–*А*-диаграмма для кристалла TMA– ZnI₄.

На рис. 6б представлена теоретическая фазовая T-P-диаграмма [18], полученная на основании рис. 7 с выбранными на нем ориентациями осей T и P. Из сравнения теоретической и экспериментальной (рис. 6а, 6б) фазовых T-P-диаграмм следует их удовлетворительное согласие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение перечислим приближения и предположения, которые были сделаны при построении теоретических фазовых диаграмм *D*–*A* и *T*–*P*.

Исходная теоретическая диаграмма строится на плоскости двух коэффициентов термодинамического потенциала D и A. Предполагается, что эти коэффициенты зависят от T и P линейно. Остальные величины: Q_L , A_γ , A_l – считаются постоянными.

Для *IC*-фазы используется одногармоническое приближение. Для соразмерных $C_{m/l}$ -фаз (кроме $C_{1/2}$ и $C_{1/3}$) используется приближение слабой анизотропии, что позволяет получить явные выражения для термодинамических потенциалов, а следовательно, и для границ между фазами. При построении диаграмм численные значения параметров берутся с точностью до одного знака, используется упрощающее расчеты предположение $A_{\gamma} = A_3$.

Перечисленные приближения и предположения не помешали получить в целом удовлетворительное согласие между теоретическими и экспериментальными фазовыми *T*—*P*-диаграммами для ряда кристаллов из семейства TMA. При этом в рассматриваемой феноменологической модели используется небольшое число параметров: Q_L , определяющий положение LT-точки, и по одному для каждой $C_{m/l}$ -фазы параметру A_l , определяющему относительную ширину $C_{m/l}$ -фазы вдоль оси D (при заданном A).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что феноменологический подход к структурным фазовым переходам, который обычно хорошо оправдывается, оказывается адекватным экспериментальным данным и в случае сложных фазовых диаграмм, на которых наряду с исходной и несоразмерной фазами существует большое число соразмерных фаз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 1. М.: Наука, 1995. 616 с.
- Sannikov D.G., Shaack G. // J. Phys.: Condens. Matter. 1998. V. 10. P. 1803.
- 3. Sannikov D.G., Shaack G. // Phys. Rev. B. 1998. V. 58. P. 8313.
- 4. *Санников Д.Г.* // Кристаллография. 1999. Т. 44. № 1. С. 158.

- 5. Gesi K. // Ferroelectrics. 1986. V. 66. P. 269.
- 6. Cummins H.Z. // Phys. Rep. 1990. V. 185. P. 211.
- 7. Санников Д.Г. // ЖЭТФ. 1989. Т. 96. С. 2189.
- Shimomura S., Hamaya N., Fujii Y. // Phys. Rev. B. 1998. V. 53. P. 8975.
- 9. Gesi K., Ozawa K. // J. Phys. Soc. Jpn. 1984. V. 53. P. 627.
- Hamaya N., Fujii Y., Shimomura Y. et al. // Solid State Commun. 1988. V. 67. P. 329.
- Hamaya N., Shimomura S., Fujii Y. // J. Phys.: Condens. Matter. 1991. V. 3. P. 3387.
- Sannikov D.G., Kessenikh G.A., Mashiyama H. // J. Phys. Soc. Jpn. 2002. V. 71. P. 1435.
- Gesi K., Ozawa K. // J. Phys. Soc. Jpn. 1982. V. 51. P. 2205.
- 14. Gesi K. // J. Phys. Soc. Jpn. 1983. V. 52. P. 2534.
- Hasebe K., Mashiyama H., Tanisaki S. et al. // J. Phys. Soc. Jpn. 1982. V. 51. P. 1045.
- Sannikov D.G., Mashiyama H. // J. Phys. Soc. Jpn. 2002. V. 71. P. 1698.
- 17. Gesi K. // J. Phys. Soc. Jpn. 1989. V. 58. P. 1532.
- Sannikov D.G., Mashiyama H. // J. Phys. Soc. Jpn. 2003. V. 72. P. 1423.